

کلید-زنی با نارساناها ی تپلژیکی

سدیم بیسموتید (Na_3Bi) یک نارسانا ی تپلژیکی ست. این مواد در کپه نارسانا یند اما در سطح رسانا. نشان داده اند لایه ی نازک ی (به کلفتی ی از مرتبه ی 10 nm) از این ماده را میشود با اعمال یک میدان الکتریکی از حالت نارسانا ی تپلژیکی (با گاف 300 meV) به نارسانا ی معمولی تبدیل کرد [1]. چنین پدیده ای ممکن است در کلید-زنی کاربرد داشته باشد.

[1] Nature **564** 390